⑲ 日本国特許庁(JP)

⑩ 特許出願公開

[®] 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-2095

®Int. CI. ⁵	識別記号·	庁内整理番号	43公開	平成2年(1990)1月8日
B 42 D 15/10 G 06 K 19/077	5 2 1	6548-2C		
H 01 L 21/50 21/56 23/00	B R A	6918-5F 6412-5F 6412-5F 6711-5B	G 06 K 19/00 李茜龙 李善龙 章	K 野ٹ頃の数 2 (人。百)

49発明の名称

I Cモジュールの製造方法及び I Cモジュール用基材

②特 顧 昭63-144448

②出 頤 昭63(1988)6月10日

②発明者 越 部 茂 東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式会社リコー内②発明者黒部 信ー 東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式会社リコー内

②出 願 人 株式会社リコー 東京都大田区中馬込1丁目3番6号

個代 理 人 弁理士 青山 葆 外1名

明 却 沒

1. 雅明の名称

I C モジュールの製造方法及び I C モジュール 用基材

2. 特許請求の範囲

(1) 薄い指状の基材表面の回路基板部に半導体 業子を載置する第1の工程と、

前記半導体素子と回路基板部上の端子とを精築 する第2の工程と、

精線された半導体素子を封止剤にて封止しなが ら封止剤を成形する第3の工程と、

封止後封止剤表面に捺印し、半導体業子の検査 及び封止された半導体業子を前記塔材からの分離 を行なう第4の工程とを備えたことを特徴とする I C モジュールの製造方法。

(2) 半導体素子の場子と接続される複数の第1 の場子部と、前記場子部と対となる複数の第2の 場子部とを備えた回路基板部が分離可能な状態で 複数、帯状に集合したことを特徴とする1Cモジュ ールの製造に使用する1Cモジュール用基材。

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は、回路基板部に集積回路案子を報置し 「Cモジュールを製作する」Cモジュールの製造 方法と、前記製造方法に使用する」Cモジュール 用基材に関する。

[従来の技術]

半母体案子の対止方法として従来より帯状の海いテープ上にパターニングされた個箔パターンに 半専体案子をポンディングし間筋にて前記半導体 業子を対止するテープ オートメイテッド ポン ディング(以下TABと略す)方法、基板上に配線 後続された半導体業子に被状の間略を適下し、前 記聞船を加熱硬化させ半導体素子を封止する、チッ ブオンボード(以下COBと略す)方法、半導体業 子が装塡された金型に予熱した間筋を入れ封入成 影するトランスファ破形方法及び金属、セラミッ ク.ガラスにで半導体業子を無常対止するハーメ チックシール方法等が知られている。尚、半導体 素子を閉筋にて対止する方法には上記以外にも数 種類の方法が知られている。

上記方法の一例として、TAB方法の概略図を第6図(a)に、第6図(a)のA-A断面図を第6図(b)に示し、以下にTAB方法にて製造される集積回路(以下(Cと略す)モジュールの構成を説明する。尚、1Cモジュールとは、半導体業子が上述したような方法で封止された単体を意味する。

第6図(a)及び第6図(b)において、ポリイミド ちにてなる 薄い 帯状のテープ 30の中央部には 方形状の穴 31が明けられる。テープ 30の片表面上には、穴 31の長手方向の2辺のそれぞれの辺と 直角に複数の 綱 着 32 k で 所隔にパターニング される。尚、 綱 宿 32 k で 網 管 32 k と は 接触していない。次に、テープ 30の穴 31には、 半導体素子 33がパンプ 34を介して穴 31に延在する 綱 着 32 a 及び 媧 宿 32 b にまたがって接続される。 さらに、 半導体素子 33 を プテープ 30の 穴 31 部は、 船 瞬にてなる 針 止 刺 35でテープ 30の 両

る。

又、COB方法においては、ICモジュールの 厚さは薄くできるが、ICモジュールの外形寸法 の均一性に欠けたり、回路基盤に実装してしまう と不良半導体素子の交換ができないという欠点が ある。

又、トランスファ成形方法においては、金型で 成形されることからICモジュールの外形寸法は 製品毎に均一であり、大量生産を行なうことがで きる。しかしICモジュールの厚さが厚くなるこ とや生産コストが高いという欠点がある。

又、ハーメチックシール方法においても、前述 のトランスファ成形方法と同様の長短所がある。

本発明は上述した問題点を解決するためになされたもので、製造される I C モジュールは、厚さが薄く、外形寸法が製品師に均一であり、大量生産が可能で、生産コストが低くさらに、実装した際不良品を良品に交換する交換性のよい I C モジュールの製造方法及び前記製造に使用する I C モジュール用基材を提供することを目的とする。

面より封止され、ICモジュールが形成される。 [発明が解決しようとする課題]

上述のような方法で製造されるICモジュールを評価する項目としては、製造されたICモジュールを回路構収に実装する際、ICモジュールが占める面積を小さくするために、ICモジュールの呼さが薄いこと及びICモジュールの外形寸法が均一なこと、さらに大量生産できること、回路基板に実装したICモジュールが放降している場合、良品と交換できること及び生産コストが安価なこと等があげられる。

ところが上述したICモジュールの製造方法は、 それぞれの一長一短があり上記のICモジュール の評価項目の絶でについて満足しないという問題 点があった。

例えばTAB方法においては、大量生産は可能 であるが、前記パンプの素材コストが高価なこと や、製造された I Cモジュールを回路基板に実装 する際、専用工具が必要であることなどから加工 費が高価となり、生産コストが高くなる欠点があ

[課題を解決するための手段]

本発明のICモジュールの製造方法は、 添い帯状の 基材表面の回路 基板部に半導体案子を被置する第1の工程と、前記半導体案子と回路 基板部上の端子とを結算する第2の工程と、結算された半導体案子を対止剤にて対止しながら対止剤を成形する第3の工程と、対止後対止剤表面に捺印し、半導体案子の検査及び封止された半導体案子を前記基材からの分離を行なう第4の工程とを備えたことを特徴とする。

上記のような工程を備えることで、第1、第2 及び第4の工程は、ICモジュールの大鼠生産を 可能にする。第3の工程は、封止剤を成形するこ とにより製造されるICモジュールの外形寸法を 均一化しさらに、ICモジュールの厚さを称くする。

さらに本発明のICモジュール用抵材は、半導体来子の端子と接続される複数の第1の端子部と、 前起端子部と対となる複数の第2の端子部とを備 えた回路基板部が分離可能な状態で複数、排伏に 集合したことを特徴とする。

上記のように構成することで、第2の場子邸は、 回路基板邸表面上に形成される。回路基板邸表面 上に第2の端子部が形成されることは、実装後の ICモジュールの交換性を向上させる。

[実施例]

本発明の一実施例を示す第1図(a)ないし第1図(g).第2図(a)及び第2図(b)において、1は、例えばガラスエポキシ間脂やポリイミド等の有機材料にてなるテープであり、テープ1の側縁部1bには、テープ1を等間隔ずつ移送する際に移送部(図示せず)のギアの間と係合する送穴1dが複数個等間隔に空けられている、顔い帯状の写真機用の最影フィルム形状のものである。又、テープ1の中央部には「字形状又はチャンネル形状の複穴になる切欠部1aが互いに接触しない傾に適宜な間隔を有して複数形成される。したがってテープ1の中央部には、テープ1の側縁部1bと支持部1cにて支持される方形状の回路基板部2が

示すように、製造方法によっては、パッド2bと外部接続端子2cとはテープ1の半導体素子接続側とテープ1の返面とに形成されず、テープ1の 返面に形成される外部接続端子2cの外表面がテープ1の半導体素子接続側に露出しパッド2bとなる場合もある。

以上のように構成された半導体素子接続側の回路基板部2のアイランド2aには第1図(b)及び第1図(f)に示すように半導体業子3が視置される。そして第1図(c)及び第4図に示すように半導体業子3の接続端子(図示せず)と回路基板部2の各パッド2bとは金属にてなるワイヤ4を使用し公知のワイヤボンディング方式により接続される。又、第1図(f)及び第5図に示すように、半導体素子3の接続端子と前記パッド2bとは、金属にてなるパンプ5を介し公知のフリップチップ方式にて接続してもよい。

災数個形成される。

第2図(a)に示すように回路基板部2の集積回路架子を接置路架子接続側には、中央部に集積回路架子を接置する部分である方形状のアイランド2aが形成され、アイランド2a部の対向する2辺に平行な状態で金属にてなる複数のパッド2bが、電気的に互いに絶縁されて一列に並んで形成される。

第2図(b)は、第2図(a)に示すテーブ1の裏面を示している。回路基板第2の対向する2辺から回路基板第2の中央部に向い金属にてなる複数の外部接続端子2cが互いに電気的に絶縁されて形成される。尚、回路基板部2の裏面に形成される外部接続端子2cの配置形態は、上述した例に限らず、第3図(a)に示すように回路基板部2の4辺から形成されてもいいし、例えば1Cカード用の1Cモジュールとして第3図(b)に示すように、回路基板部2の裏面全面に外部接続端子2cを形成してもよい。尚、前述したパッド2bと、外部接続端子2cとは第4図及び第5図に示すように1対1に対応しているものである。又、第4図に

止部2dとは樹脂にてなる対止剤6にて対止される。尚、対止剤6としては熱硬化性又は熱可塑性の樹脂のどちらでも良い。尚、製造されたICモジュールが実装される際、ハンダ付けが行なわれる場合があるので、対止剤6は、例えばエポキシ樹脂のような耐熱性の高い樹脂が好ましい。尚、ICモジュールが樹脂接着による方法で実装されるならば、対止剤6に対する耐熱性はさほど厳しくなくても良い。

又、半導体業子3の対止剤6による対止方法としては、半導体業子3の上方より対止剤6を半導体業子3へ適下し、金型にて成形する方法を使用する。この方法によれば、製造される[Cモジュールの外形寸法は、製品毎に均一化されるので、製造された[Cモジュールを回路基板に実装する際、本発明の方法による[Cモジュールは、省スペース及び取付け位置の設定等に有利である。又、本発明の1Cモジュールの製造方法によれば、樹齢対止するのは半導体業子3及び樹脂対止即2dが設けられる回路基板第2の片面だけでよいので、

特閒平2-2095(4)

製造される I C モジュールの厚さを減くすることができる。 尚、樹脂封止する際の空気を達がす部分として第2図(a)に示すように樹脂封止部2dにはベント2eが設けられている。

又、対止剤6の設置場所を除く回路基板部2の 露出部2fは、外気と接するので耐湿処理を施し ている。

次の工程では、半導体業子3等を封止した封止 剤6の上表面には、製品の型式等を示す協印がな され、半導体業子3の製品検査がなされた後、回 路基板部2と、テーブ1の側線部1bとを継いで いる支持部1cにで回路基板部2はテーブ1から 切り離され、1Cモジュールとして製品化される。

以上のように、半導体素子の模型及び半導体業子の材性は、連続して概遂されるテープ上にで行なわれるので、連続して作業工程を進めることができる。又、生産途中の移送も前紀テープを移動すればよく簡単である。したがって本発明の方法によれば I C モジュールを大量に生産することができ、よって I C モジュールの単価も下げること

・のが縦10mm×横15mm×厚さ1.0mm・トランスファ方法によるものが縦11mm×横19mm×厚さ2.5mm及び本発明の方法によるものが縦10mm×機15mm×厚さ1.0mmである。単価については、TAB方法によるものが350円.СОB方法によるものが370円、トランスファ成形方法によるものが300円及び本発明の方法によるものが370円である。交換性については、TAB方法による1Cモジュールは前述したように、鍵しく、COB方法によるものは実装した1Cモジュールごと封止剤にて封止するので不可であり、トランスファ成形方法及び本発明の方法によるものとは交換可能である。

以上のことより、外形寸法の厚さの観点からではTAB方法、COB方法及び本発明の方法が良い。単価の観点からではCOB方法及び本発明の方法が良い。交換性の観点からでは、トランスファ 成形方法及び本発明の方法が良いことが判る。したがって【Cモジュールの厚さ、単価及び交換性の総でに本発明の方法は優れていることが判る。

ができる。

又、回路基板に実装後 I C モジュールの不良等で I C モジュールを交換する場合、従来の方法によれば例えば第 6 図(b)に示すように嗣高がデーブ上より延在し、この延在している部分にて嗣高は四路基板に接続されていたので、交換時に前記嗣高が切れたりして I C モジュールの交換性は良くなかった。しかし、本発明の方法にて生産される I C モジュールは外部接続端子は第 2 図(b)に示すように回路基板部より突出していないので、交換時に外部接続端子が切断するようなことはない。よって I C モジュールの交換性は良い。

以体的に示すと、例えば64キロビットの記憶 容別で28ビンの外部接続端子を有する1Cモジュ ールを製造した場合の外形寸法、単価及び実装後 の交換性について、従来例であるTAB方法、C OB方法の及びトランスファ成形方法と、本発明 の方法とを比較してみる。まず外形寸法について は、TAB方法による1Cモジュールは、縦11 mm×横19mm×厚さ1.0mm,COB方法によるも

[発明の効果]

以上詳述したように本発明によれば、チープ状 の基材に第1及び第2の端子を備え、基材と分離 可能な複数の回路活版部上に半導体素子を視置し、 半導体素子と前記回路基板部上の第1の端子とを 接続し、半導体素子を破竄した前記回路基版部の 片面側のみ封止剤にて成形しながら、半導体業子 を封止するので、製造されるICモジュールは、 厚さが薄く、外形寸法が製品毎に均一となる。又、 本発明のICモジュールの製造方法は、テープ状 の基材に複数の回路基板部を設け、半導体常子が 封止された回路基板部は基材から容易に分離でき るので、大量生産が可能となる。又、大量生産が 可能となるので生産コストを低下させることがで きる。さらに第2の端子は前紀回路基板邪表面上 に固着形成されるので、実装したICモジュール を交換する際第2の端子が損傷することはない。 したがって1Cモジュールの交換性が良くなる。 4. 図面の簡単な説明

第1図(a)ないし第1図(g)は、本発明のICモ

持閒平2-2095 (5)

ジュールの製造方法の一例を示す図、第2図(a) は、本発明の1 Cモジュールの製造方法に使用する基材を示す平面図、第2図(b)は第2図(a)の裏面図、第3図(a)及び第3図(b)は、本発明の方法にて製造される1 Cモジュールの外部接続違子の配置例を示す図、第4図及び第5図は、本発明の方法にて製造される1 Cモジュールの機断面図、第6図(a)は、従来の製造方法の一例を示す図、第6図(b)は、従来の製造方法の一例を示す図、第6図(b)は、従来の1 Cモジュールの機断面図である。

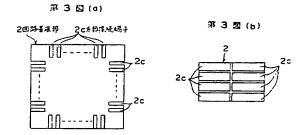
Ⅰ…テープ、 2…回路基仮部、

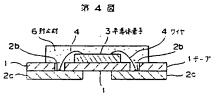
2 b…パッド、 2 c…外部接続端子、

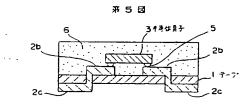
3…単原体諸子、4…ワイヤ、

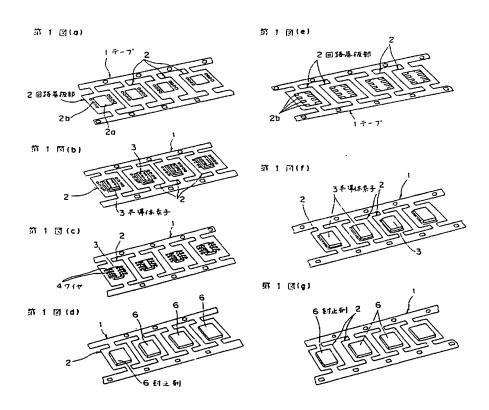
5…パンプ、 6…封止剤。

特許出願人 株式会社 リ コ ー 代 理 人 弁理士 青山 葆 外1名









特閒平2-2095 (6)

